

产品概览

FDC3535: -80V P 沟道 PowerTrench® MOSFET

欲看完整文档，请参阅数据表。

此P沟道MOSFET采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产，这一先进工艺已针对 $r_{DS(on)}$ 、开关性能和稳固性进行了优化。

特性

- $V_{GS} = -10\text{ V}$ ， $I_D = -2.1\text{ A}$ 时，最大 $r_{DS(on)}$ = 183mΩ
- $V_{GS} = -4.5\text{ V}$ ， $I_D = -1.9\text{ A}$ 时， $r_{DS(on)}$ = 233 mΩ （最大值）
- 高性能沟道技术可实现极低的 $r_{DS(on)}$
- 高功率和高电流处理能力，采用广泛使用的表面贴装封装
- 快速开关速度
- 100%经过UIL测试
- 符合RoHS标准

应用

- This product is general usage and suitable for many different applications.

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS}^{(BR)}$ Min (V)	V_{GS}^{Max} (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	I_D^{Max} (A)	P_D^{Max} (W)	$R_{DS(on)}$ n) Max @ $V_{GS} = 2.5\text{ V}$ (mΩ)	$R_{DS(on)}$ n) Max @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$ (mΩ)	$R_{DS(on)}$ n) Max @ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (mΩ)	Q_3 Typ @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$ (nC)	Q_3 Typ @ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (nC)	C_{iss} Typ (pF)	Package Type
FDC3535	0.2467	Pb-free Halide free	Active	P-Channel	Single	-80	±20	-3	-2.1	1.6	-	233	183	-	6.8	659	TSO T-23-6

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于：4/2/2020